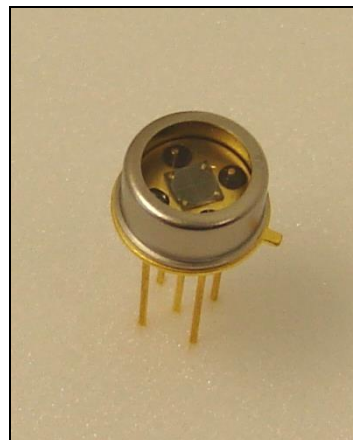


Charakteristik :

- ◆ monolithische SiC-Quadranten-Photodiode mit gemeinsamer Kathode
- ◆ strahlungsempfindliche Fläche: 4 x 1,25mm²
- ◆ Spektralbereich: 215 ... 360 nm
- ◆ hohe UV-Empfindlichkeit: 0,16 A/W
- ◆ hermetisches TO39-Gehäuse
- ◆ RoHS, REACH und WEEE konform

Applikationen :

- ◆ Nullpunktmessung von Laserstrahlbündeln
- ◆ hochauflösende Autokollimatoren
- ◆ xy - Koordinatenmessgeräte
- ◆ faseroptische Beschleunigungs- und Winkelsensoren
- ◆ Anwendungen mit hoher Positionsauflösung

**Grenzwerte :**

- ◆ Sperrspannung 20 V
- ◆ Betriebstemperaturbereich - 40 °C ... 125 °C
- ◆ Lagertemperaturbereich - 40 °C ... 125 °C
- ◆ Löttemperatur (3s) 260 °C

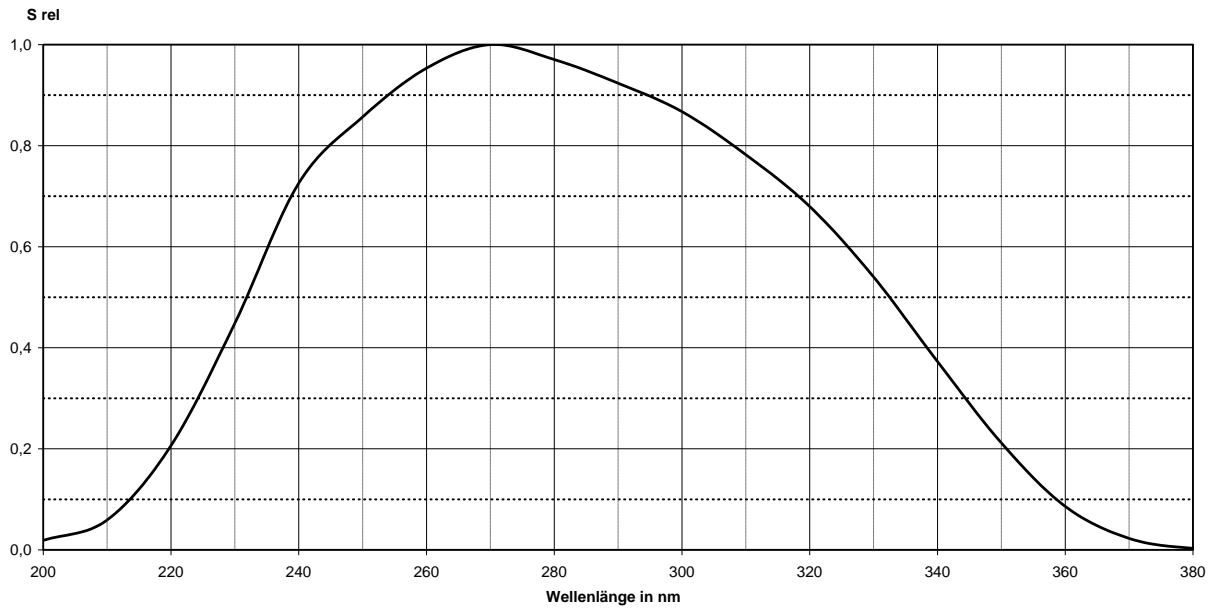
Technische Daten :

Parameter	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einh.
strahlungsempfindliche Fläche			1,25		mm ²
Durchmesser der aktiven Fläche			2,525		mm
Separation der Teilflächen			32		µm
Maximum der spektralen Empfindlichkeit S_{max}			270		nm
Spektralbereich λ_{max} λ_{min}	$S = 0,1 \cdot S_{max}$		215 360		nm
spektrale Empfindlichkeit bei Hg-ND	$\lambda = 254 \text{ nm}$		0,14		A/W
Dunkelstrom I_R	$E = 0 \text{ lx}$		100		fA
Anstiegszeit t_r des Fotostromes	$R_L = 50 \Omega$ $\lambda = 254 \text{ nm}$ $I_P = 10 \mu A$		tbc		ns
Kapazität	$F = 1 \text{ MHz}$ $E = 0 \text{ lx}$		250		pF

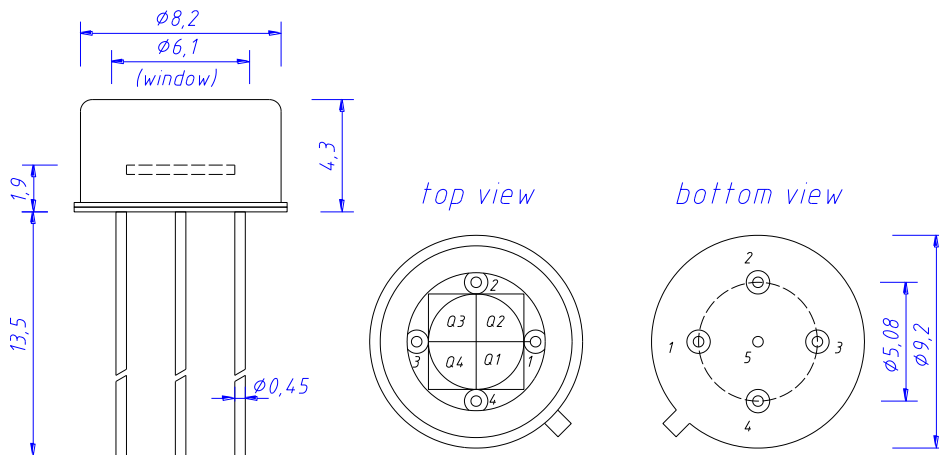
Allgemeine Meßbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: $T_A = 25 \text{ °C}$, $V_R = 10 \text{ V}$
Meßwerte gelten für ein Element, sofern nicht anders spezifiziert !

Rev. 2 (03/2016)

relative spektrale Empfindlichkeit



Gehäuseabmessungen



Anschlußbelegung

- 1 Anode Quadrant 1
- 2 Anode Quadrant 2
- 3 Anode Quadrant 3
- 4 Anode Quadrant 4
- 5 Katode & Case